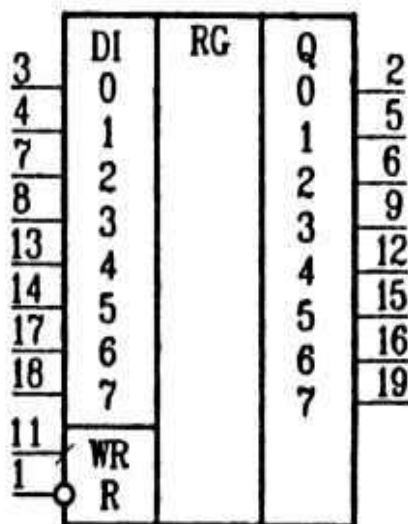


КР1533ИР35, КФ1533ИР35, ЭКФ1533ИР35

Микросхемы представляют собой 8-разрядный регистр на D-триггерах с общим входом сброса. Корпус типа 2140.20-8, масса не более 2,6 г и 4321.20-В.

Назначение выводов: 1 - вход сброса \overline{R} ; 2, 6, 9, 12, 15, 16, 19 - входы данных Q0...Q7; 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18 - входы данных DI0...DI7; 10 - общий; 11 - вход разрешения записи WR; 20 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ИР35, КФ1533ИР35, ЭКФ1533ИР35

Таблица истинности

Вход			Выход
\overline{R}	WR	D	Q
1		1	1
1		0	0
1	0	X	Q0
0	X	X	0

Примечание. X - любое состояние (1 или 0).

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания 5 В ± 10%

Выходное напряжение низкого уровня:

- при $I_{\text{вых}}^0 = 12 \text{ мА}$ ≤ 0,4 В

- при $I_{\text{вых}}^0 = 24 \text{ мА}$ ≤ 0,5 В

Выходное напряжение высокого уровня

при $I_{\text{вых}}^1 = -2,6 \text{ мА}$ ≥ 2,4 В

Прямое падение напряжения на антизвонном диоде	$\leq -1,5 $ В
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения, при $U_n = 5,5$ В	≤ 20 мА
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения, при $U_n = 5,5$ В	≤ 29 мА
Входной ток низкого уровня	$\leq -0,2 $ мА
Входной ток высокого уровня	≤ 20 мкА
Входной пробивной ток	$\leq 0,1$ мА
Выходной ток	$ -30 \dots -112 $ мА
Время задержки распространения сигнала при включении:	
- по входу WR	≤ 15 нс
- по входу \bar{R}	≤ 18 нс
Время задержки распространения сигнала при выключении по входу WR	≤ 12 нс

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5 В
Температура окружающей среды	-10...+70 °С

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более

270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В \pm 10%, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.